

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第4837811号
(P4837811)

(45) 発行日 平成23年12月14日(2011.12.14)

(24) 登録日 平成23年10月7日(2011.10.7)

(51) Int.Cl.		F I	
H05B 33/22	(2006.01)	H05B 33/22	Z
H01L 51/50	(2006.01)	H05B 33/14	A
H05B 33/28	(2006.01)	H05B 33/28	
H05B 33/26	(2006.01)	H05B 33/26	Z

請求項の数 4 (全 13 頁)

<p>(21) 出願番号 特願平10-114324 (22) 出願日 平成10年4月9日(1998.4.9) (65) 公開番号 特開平11-297478 (43) 公開日 平成11年10月29日(1999.10.29) 審査請求日 平成16年12月10日(2004.12.10)</p> <p>前置審査</p>	<p>(73) 特許権者 000183646 出光興産株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号</p> <p>(74) 代理人 100086759 弁理士 渡辺 喜平</p> <p>(74) 代理人 100112977 弁理士 田中 有子</p> <p>(72) 発明者 細川 地潮 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地</p> <p>審査官 池田 博一</p>
--	---

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1電極層、無機非縮退半導体層、有機発光層を含む一層以上の有機層および第2電極層を順次に積層した構造を有し、

前記無機非縮退半導体層は、非晶質材料を含み、かつ、有機発光層のバンドギャップエネルギーよりも大きな2.7eV~6.0eVのバンドギャップエネルギーを有し、

前記無機非縮退半導体層は、Inを主成分として含み、かつ

InおよびZn、

In、ZnおよびAl、

In、ZnおよびSi、

In、ZnおよびTi、

In、ZnおよびSb、

In、ZnおよびMg、

In、GaおよびSi、

In、GaおよびAl、

In、ZnおよびBa、

In、ZnおよびSr、

In、ZnおよびYb、

In、ZnおよびGa、

In、ZnおよびTa

の組み合わせのうち、いずれかの組み合わせの元素を含む、酸化物を主成分とし、

前記無機非縮退半導体層中のキャリア濃度を、 $10^{19} \text{ cm}^{-3} \sim 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ の範囲内の値とした

ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子において、

前記無機非縮退半導体層を、正孔伝導性とした

ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 3】

請求項 1 に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子において、

前記無機非縮退半導体層を、電子伝導性とした

ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 4】

請求項 1 ~ 請求項 3 のいずれか一つの請求項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子において、

前記無機非縮退半導体層中の局在準位の密度を、 10^{17} cm^{-3} 未満の値としたことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子（以下、「有機EL素子」とも称する。）に関する。さらに詳しくは、民生用および工業用の表示機器（ディスプレイ）あるいはプリンターヘッドの光源等に用いて好適な有機EL素子に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来の有機EL素子の一例が、文献1：「特開平1-312873号公報」、文献2：「特開平2-207488号公報」、文献3：「特開平5-41285号公報」および文献4：「特開平6-119973号公報」にそれぞれ開示されている。これらの文献に開示の有機EL素子は、正孔注入層または電子注入層としての無機半導体層と有機発光層とを積層した構造を有している。そして、有機層よりも劣化の少ない無機半導体層を用いることにより、素子の寿命を向上させている。

【0003】

また、文献1においては無機半導体層の材料として、例えば、非晶質の $\text{Si}_{1-x}\text{C}_x$ で表されるIII-V族やII-V族の非結晶質材料やCuI、CuS、GaAsおよびZnTeなどの結晶質材料が用いられている。

また、文献3および文献4においては、無機半導体層の材料として、 Cu_2O をはじめとする結晶質の酸化物半導体材料を用いる例が開示されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上述の文献1および文献2に開示の有機EL素子において、CuIなどの結晶質の材料を用いた場合には、通常多結晶の無機半導体層が形成される。多結晶の無機半導体層の表面は、平坦性が悪く、50nm程度以上の凹凸がある。このため、多結晶の無機半導体層上に有機発光層の薄膜を形成した場合、無機半導体層の表面の凸部が、薄膜を突き抜けてしまう場合がある。その場合、無機半導体層と有機発光層上の電極とが短絡して、リーク電流が発生する。また、短絡しなくとも凸部に電界集中が発生するため、リーク電流が発生しやすい。このため、従来の有機EL素子には、発光効率が低下するという問題点があった。

【0005】

なお、無機半導体層を形成する際には、有機発光層の耐熱温度よりも高い温度（200以上）となる。このため、有機発光層は、無機半導体層を形成した後に形成される。

10

20

30

40

50

【 0 0 0 6 】

また、文献 1 および文献 2 に開示の有機 E L 素子において用いられている $S i_{1-x} C_x$ の非晶質材料のエネルギーギャップは、 $2.6 eV$ よりも小さい。これに対して、アルミニウム錯体やスチルベン誘導体といった発光体を含む有機発光層のエネルギーギャップは、 $2.6 eV$ よりも大きい。その結果、有機発光層で生成された励起状態は、無機半導体層へエネルギー移動して失活しやすい。このため、有機 E L 素子の発光効率が低下するという問題があった。

【 0 0 0 7 】

また、非晶質材料として、シリコン系の材料 ($-Si$ 、 $-SiC$) を用いた場合、ダングリングボンドによる局所準位が、エネルギーバンドギャップ中に $10^{17} cm^{-3}$ 以上存在する。このため、たとえバンドギャップエネルギーが大きくても、この局在準位のため励起状態が失活する。このため、有機 E L 素子の発光効率が低下するという問題があった。

10

【 0 0 0 8 】

また、上述の文献 3 および文献 4 において用いられる Cu_2O などの酸化物半導体は結晶質である。 Cu_2O などの酸化物半導体は、高温で焼成されるため、通常多結晶となる。この場合も、文献 1 および文献 2 の場合と同様に、表面の凹凸のためにリーク電流が発生して、発光効率が低下するという問題点があった。

【 0 0 0 9 】

本発明は、上記の問題にかんがみてなされたものであり、発光効率の良い有機 E L 素子の提供を目的とする。

20

【 0 0 1 0 】

【課題を解決するための手段】

この目的の達成を図るため、本発明の有機 E L 素子によれば、第 1 電極層、無機非縮退半導体層、発光層を含む一層以上の有機層および第 2 電極層を順次に積層した構造を有し、無機非縮退半導体層は、非晶質性材料または微結晶材料を含み、かつ、有機発光層のバンドギャップエネルギーよりも大きなバンドギャップエネルギーを有することを特徴とする。

【 0 0 1 1 】

このように、この発明の有機 E L 素子によれば、無機非縮退半導体層が非晶質材料または微結晶材料を含む。その結果、無機非縮退半導体層の表面が平坦となる。その結果、表面の凹凸に起因するリーク電流の発生を防止を図ることができる。このため、発光効率の向上を図ることができる。

30

【 0 0 1 2 】

また、この発明の有機 E L 素子によれば、無機非縮退半導体層のバンドギャップエネルギーを、有機発光層のバンドギャップエネルギーよりも大きくした。その結果、有機発光層で生成された励起状態が、無機非縮退半導体層へエネルギー移動して失活することの低減を図ることができる。このため、発光効率の向上を図ることができる。

【 0 0 1 3 】

また、この発明の有機 E L 素子において、好ましくは、無機非縮退半導体層のバンドギャップエネルギーを $2.7 eV$ 以上 $6 eV$ 以下の範囲内の値とするのが良い。前述したように、アルミニウム錯体やスチルベン誘導体を含む有機発光層のエネルギーギャップは、 $2.6 eV$ よりも大きい。このため、無機非縮退半導体層のバンドギャップエネルギーを $2.7 eV$ 以上とすれば、励起状態の失活の低減を図ることができる。

40

【 0 0 1 4 】

また、この発明の有機 E L 素子において、好ましくは、無機非縮退半導体層を、正孔伝導性とするのが良い。すなわち、無機非縮退半導体層は、正孔注入層として機能しても良い。

【 0 0 1 5 】

また、この発明の有機 E L 素子において、好ましくは、無機非縮退半導体層を、電子伝導

50

性とするのが良い。すなわち、無機非縮退半導体層は、電子注入層として機能しても良い。

【0016】

また、この発明の実施にあたり、無機非縮退半導体層を、Ba（バリウム）、Ca（カルシウム）、Sr（ストロンチウム）、Yb（イッテルビウム）、Al（アルミニウム）、Ga（ガリウム）、In（インジウム）、Li（リチウム）、Na（ナトリウム）、Cd（カドミウム）、Mg（マグネシウム）、Si（ケイ素）、Ta（タンタル）、Sb（アンチモン）、Ti（チタン）およびZn（亜鉛）の元素うちのいずれか1つ以上の元素含む酸化物または酸化窒化物を主成分とすると良い。

【0017】

また、この発明の実施にあたり、無機非縮退半導体層を、InおよびZnの組み合わせ、Al、ZnおよびSiの組み合わせ、In、ZnおよびTiの組み合わせ、In、ZnおよびSbの組み合わせ、In、ZnおよびYbの組み合わせ、In、ZnおよびGaならびに、In、ZnおよびTaの組み合わせの元素のうち、いずれかの組み合わせの元素を含む、酸化物または酸化窒化物とすると良い。

【0018】

また、この発明において、無機非縮退半導体層中のキャリア濃度を、 $10^{19} \text{ cm}^{-3} \sim 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ の範囲内の値とすると良い。

このように、無機非縮退半導体層中のキャリア濃度を低くすれば、無機半導体が有機発光層中で生成した励起状態と相互作用をする可能性が低くなる。その結果、発光効率の低下を回避することができる。

【0019】

また、この発明において、無機非縮退半導体層中の局在準位の密度を、 10^{17} cm^{-3} 未満とすると良い。

このように、局在準位の密度を 10^{17} cm^{-3} 未満とすれば、この局在準位による励起状態の失活の低減を図ることができる。

【0020】

また、この発明において、無機非縮退半導体層を、Inを主成分として含む酸化物を材料とすると良い。

【0021】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して、この発明の実施の形態について説明する。なお、参照する図面は、この発明が理解できる程度に各構成成分の大きさ、形状および配置関係を概略的に示してあるに過ぎない。したがって、この発明は図示例にのみ限定されるものではない。また、図面中、断面を表すハッチングを一部省略する。

【0022】

まず、図1を参照して、この実施の形態の有機EL素子100の構造について説明する。この有機EL素子100は、第1電極層としての下部電極10、無機非縮退半導体層12、有機発光層14および第2電極層としての対向電極16を順次に積層した構造を有する。

【0023】

そして、この無機非縮退半導体層12は、非晶質材料または微結晶材料を含む。このように、無機非縮退半導体層12を非晶質材料または微結晶材料でもって形成すれば、その表面は平坦となる。その結果、表面の凹凸に起因するリーク電流の発生を防止することができる。このため、発光効率が向上する。

なお、無機半導体の状態（例えば、非晶質状態や微結晶状態）は、例えば、X線解析法により検出することができる。

【0024】

その上、この無機非縮退半導体層12は、有機発光層のバンドギャップエネルギーよりも大きなバンドギャップエネルギーを有する。具体的には、無機非縮退半導体層12のバン

10

20

30

40

50

ドギャップエネルギーを $2.7 \text{ eV} \sim 6 \text{ eV}$ の範囲内の値とすると良い。

【0025】

このように、無機非縮退半導体層のバンドギャップエネルギーを大きくすれば、有機発光層 14 で生成された励起状態が、無機非縮退半導体層 12 へエネルギー移動して失活することを防ぐことができる。このため、発光効率が向上する。

なお、バンドギャップエネルギーは、例えば、透過光の吸収端波長を測定することにより求めることができる。

【0026】

また、無機非縮退半導体層 12 に正孔伝導性を持たせて、無機非縮退半導体層 12 を正孔注入層することができる。その場合、下部電極 10 を陽極とし、対向電極 16 を陰極とする。

10

【0027】

また、無機非縮退半導体層 12 に電子伝導性を持たせて、無機非縮退半導体層 12 を電子注入層とすることもできる。その場合、下部電極 10 を陰極とし、対向電極 16 を陽極とする。

【0028】

また、この発明の実施にあたり、無機非縮退半導体層 12 は、例えば、Yb (イッテルビウム)、Al (アルミニウム)、Ga (ガリウム)、In (インジウム)、Zn (亜鉛)、Cd (カドミウム)、Mg (マグネシウム)、Si (ケイ素)、Ta (タンタル)、Sb (アンチモン) および Zn (亜鉛) の元素うちのいずれか 1 つ以上の元素含む酸化物または酸化窒化物を主成分とすると良い。

20

【0029】

具体的には、酸化物または酸化窒化物としては、例えば、In および Zn の組み合わせ、Al、Zn および Sb の組み合わせ、In、Zn および Yb の組み合わせ、ならびに、In、Zn および Ta の組み合わせの元素のうち、いずれかの組み合わせの元素を含む、酸化物または酸化窒化物とすると良い。

【0030】

また、この実施の形態では、無機非縮退半導体層 12 中のキャリア濃度を、 $10^{19} \text{ cm}^{-3} \sim 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ の範囲内の値とする。

このように、キャリア濃度を低くすれば、発光効率の低下を回避することができる。

30

【0031】

これに対して、キャリア濃度が高い無機半導体、例えばキャリア濃度が 10^{19} よりも高い縮退半導体を用いた場合、キャリアと、有機発光層で生成した励起状態とが相互作用して、発光効率を低下させてしまう。

なお、キャリア濃度は、例えば、ホール効果を用いて測定することができる。

【0032】

また、この実施の形態では、無機非縮退半導体層 12 中の局在準位の密度を、 10^{17} cm^{-3} 未満とする。このように、局在準位の密度を 10^{17} cm^{-3} 未満の値とすれば、この局在準位による励起状態の失活の低減を図ることができる。

なお、局在準位の密度は、無機非縮退半導体の電流 - 電圧 - 静電容量の関係を調べることにより測定することができる。

40

また、有機発光層は、正孔伝導性を有することが望ましい。

【0033】

【実施例】

[実施例 1]

次に、この発明の実施例 1 について説明する。実施例 1 の有機 EL 素子では、下部電極を透明電極とした。

実施例 1 の有機 EL 素子を製造するにあたっては、まず、厚さ 1 mm、 $25 \text{ mm} \times 75 \text{ mm}$ のガラス基板上に、 100 nm の厚さの ITO 膜を製膜する。このガラス基板と ITO 膜とを併せて基板とする。続いて、この基板をイソプロピルアルコールで超音波洗浄する

50

。更に、基板を N_2 （窒素ガス）雰囲気中で乾燥させた後、UV（紫外線）およびオゾンを併用して30分間洗浄した。実施例1では、この下部電極を陽極とする。

【0034】

次に、この基板を日本真空社製の蒸着・スパッタ装置のチャンバに設置した。そして、ITO膜上に無機非縮退半導体層をスパッタリング（ICNS）にて製膜した。このスパッタリングにあたっては、 $InZnO_3$ 、 ZnO および Al_2O_3 の焼結体をターゲットとした。ただし、 In 、 Zn および Al に対する In の原子数比を一例として0.6とした。また、 In 、 Zn および Al に対する Al の原子数比を一例として0.1とした。

【0035】

また、スパッタリングにあたっては、チャンバ中に、アルゴンガスと酸素ガスを、（アルゴンガス）/（酸素ガス）の体積比が2.0となるように導入した。そして、スパッタリングにあたっての条件は、チャンバの真空度を 3×10^{-4} Pa、出力を50W、RF周波数を13.56MHz、カソード印加電圧を400Vとした。

【0036】

実施例1では、無機非縮退半導体層として、 $In-Zn-Al-O$ からなる酸化物層を200nmの厚さに蒸着した。なお、この酸化物は、正孔伝導性を有し、透明である。

【0037】

続いて、無機非縮退半導体層上に、有機発光層として、電子輸送性の有機化合物である8-ヒドロキシキノリンAl錯体（Alq錯体）を抵抗加熱により60nmの厚さに蒸着した。

【0038】

さらに、有機発光層上に、対向電極として、 $Al:Li$ 合金を抵抗加熱により200nmの厚さに蒸着した。実施例1では、この対向電極を陰極とする。

以上の工程を経て、実施例1の有機EL素子を形成した。

【0039】

実施例1における無機非縮退半導体層のバンドギャップエネルギーは、下記の表1に示すように、2.9eVであった。バンドギャップエネルギーの測定にあたっては、無機非縮退半導体層を構成する酸化物の透過スペクトルを測定し、その吸収端の波長に相当するエネルギーを求めた。

【0040】

また、無機非縮退半導体層の比抵抗を測定したところ、 1×10^{-3} Ω・cmであった。また、無機非縮退半導体層をX線回折で測定したところ、無機非縮退半導体層の状態は非晶質であった。

【0041】

そして、下部電極と対向電極との間に6Vの電圧を印加して、素子を定電圧駆動した。このときの初期輝度は、 100 cd/m^2 であり、発光効率は 1.2 lm/W であった。また、7.5Vの電圧を印加した駆動したときの初期輝度は、 170 cd/m^2 であった。そして、半減寿命は、750時間であった。なお、半減寿命とは、輝度が、初期輝度の半値になるまでに要する時間をいう。

【0042】

[実施例2]

次に、この発明の実施例2について説明する。実施例2の有機EL素子の構造は、実施例1の素子の構造と同様である。ただし、実施例2においては、無機非縮退半導体層として、 $In-Zn-Si-O$ からなる酸化物の層をスパッタリングにより形成した。なお、この酸化物は、正孔伝導性を有し、透明である。

【0043】

スパッタリングにあたっては、 In 、 Zn および Si に対する In の原子数比を0.57~0.6の範囲内の値とした。また、 In 、 Zn および Si に対する Si の原子数比を0.1~0.23の範囲内の値とした。その他のスパッタリングの条件は、実施例1と同一条件とした。

10

20

30

40

50

【 0 0 4 4 】

実施例 2 における無機非縮退半導体層のバンドギャップエネルギーは、下記の表 1 に示すように、 2.9 eV であった。また、比抵抗は、 $1 \times 10^2 \cdot \text{cm}$ であった。また、無機非縮退半導体層の状態は、非晶質であった。

そして、 7.5 V の電圧を印加して定電圧駆動したときの発光効率は 1.21 m/W であった。また、半減寿命は、 800 時間であった。

【 0 0 4 5 】

[実施例 3]

次に、この発明の実施例 3 について説明する。実施例 3 の有機 EL 素子の構造は、実施例 1 の素子の構造と同様である。ただし、実施例 3 においては、無機非縮退半導体層として、 In-Zn-Mg-O からなる酸化物の層をスパッタリングにより形成した。なお、この酸化物は、正孔伝導性を有し、透明である。

10

【 0 0 4 6 】

スパッタリングにあたっては、 In 、 Zn および Mg に対する In の原子数比を $0.57 \sim 0.6$ の範囲内の値とした。また、 In 、 Zn および Mg に対する Mg の原子数比を $0.1 \sim 0.23$ の範囲内の値とした。その他のスパッタリングの条件は、実施例 1 と同一条件とした。

【 0 0 4 7 】

実施例 3 における無機非縮退半導体層のバンドギャップエネルギーは、下記の表 1 に示すように、 3.0 eV であった。また、比抵抗は、 $2 \times 10 \cdot \text{cm}$ であった。また、無機非縮退半導体層の状態は、微結晶（マイクロクリスタル）であった。

20

そして、 7.5 V の電圧を印加して定電圧駆動したときの発光効率は 1.51 m/W であった。また、半減寿命は、 1200 時間であった。

【 0 0 4 8 】

[実施例 4]

次に、この発明の実施例 4 について説明する。実施例 4 の有機 EL 素子の構造は、実施例 1 の素子の構造と同様である。ただし、実施例 4 においては、無機非縮退半導体層として、 In-Zn-Yb-O からなる酸化物の層をスパッタリングにより形成した。なお、この酸化物は、正孔伝導性を有し、透明である。

【 0 0 4 9 】

スパッタリングにあたっては、 In 、 Zn および Yb に対する In の原子数比を $0.57 \sim 0.6$ 範囲内の値とした。また、 In 、 Zn および Yb に対する Yb の原子数比を $0.1 \sim 0.23$ の範囲内の値とした。その他のスパッタリングの条件は、実施例 1 と同一条件とした。

30

【 0 0 5 0 】

実施例 4 における無機非縮退半導体層のバンドギャップエネルギーは、下記の表 1 に示すように、 3.1 eV であった。また、比抵抗は、 $3 \times 10^{-1} \cdot \text{cm}$ であった。また、無機非縮退半導体層の状態は、非晶質であった。

そして、 7.5 V の電圧を印加して定電圧駆動したときの発光効率は 1.01 m/W であった。また、半減寿命は、 650 時間であった。

40

【 0 0 5 1 】

[実施例 5]

次に、この発明の実施例 5 について説明する。実施例 2 の有機 EL 素子の構造は、実施例 1 の素子の構造と同様である。ただし、実施例 2 においては、無機非縮退半導体層として、 In-Ga-Si-O からなる酸化物の層をスパッタリングにより形成した。なお、この酸化物は、正孔伝導性を有し、透明である。

【 0 0 5 2 】

スパッタリングにあたっては、 In 、 Ga および Si に対する In の原子数比を $0.57 \sim 0.6$ の範囲内の値とした。また、 In 、 Ga および Si に対する Si の原子数比を $0.1 \sim 0.23$ の範囲内の値とした。その他のスパッタリングの条件は、実施例 1 と同一

50

条件とした。

【0053】

実施例5における無機非縮退半導体層のバンドギャップエネルギーは、下記の表1に示すように、 3.0 eV であった。また、比抵抗は、 $3 \times 10^{-2} \cdot \text{cm}$ であった。また、無機非縮退半導体層の状態は、微結晶であった。

そして、 7.5 V の電圧を印加して定電圧駆動したときの発光効率は 0.91 lm/W であった。また、半減寿命は、 700 時間であった。

【0054】

[実施例6]

次に、この発明の実施例6について説明する。実施例6の有機EL素子の構造は、実施例1の素子の構造と同様である。ただし、実施例6においては、無機非縮退半導体層として、 In-Ga-Al-O からなる酸化物の層をスパッタリングにより形成した。なお、この酸化物は、正孔伝導性を有し、透明である。

10

【0055】

スパッタリングにあたっては、 In 、 Ga および Al に対する In の原子数比を $0.57 \sim 0.6$ の範囲内の値とした。また、 In 、 Ga および Al に対する Al の原子数比を $0.1 \sim 0.23$ の範囲内の値とした。その他のスパッタリングの条件は、実施例1と同一条件とした。

【0056】

実施例6における無機非縮退半導体層のバンドギャップエネルギーは、下記の表1に示すように、 2.9 eV であった。また、比抵抗は、 $1 \times 10 \cdot \text{cm}$ であった。また、無機非縮退半導体層の状態は、微結晶であった。

20

そして、 7.5 V の電圧を印加して定電圧駆動したときの発光効率は 1.31 lm/W であった。また、半減寿命は、 720 時間であった。

【0057】

[実施例7]

次に、この発明の実施例7について説明する。実施例7の有機EL素子の構造は、実施例1の素子の構造と同様である。ただし、実施例7においては、無機非縮退半導体層として、 In-Zn-Ta-O からなる酸化物の層をスパッタリング形成した。なお、この酸化物は、正孔伝導性を有し、透明である。

30

【0058】

スパッタリングにあたっては、 In 、 Zn および Ta に対する In の原子数比を $0.57 \sim 0.6$ の範囲内の値とした。また、 In 、 Zn および Ta に対する Ta の原子数比を $0.1 \sim 0.23$ の範囲内の値とした。その他のスパッタリングの条件は、実施例1と同一条件とした。

【0059】

実施例7における無機非縮退半導体層のバンドギャップエネルギーは、下記の表1に示すように、 22.8 eV であった。また、比抵抗は、 $7 \times 10 \cdot \text{cm}$ であった。また、無機非縮退半導体層の状態は、非晶質であった。

40

そして、 7.5 V の電圧を印加して定電圧駆動したときの発光効率は 1.21 lm/W であった。また、半減寿命は、 450 時間であった。

【0060】

[実施例8]

次に、この発明の実施例8について説明する。実施例8の有機EL素子の構造は、実施例1の素子の構造と同様である。ただし、実施例8においては、無機非縮退半導体層として、 In-Zn-Si-O-N からなる酸化物の層をスパッタリングにより形成した。なお、この酸化物は、正孔伝導性を有し、透明である。

【0061】

実施例8における無機非縮退半導体層のバンドギャップエネルギーは、下記の表1に示すように、 3.1 eV であった。また、比抵抗は、 $7 \times 10^3 \cdot \text{cm}$ であった。また、無

50

機非縮退半導体層の状態は、非晶質であった。

そして、7.5Vの電圧を印加して定電圧駆動したときの発光効率は1.4lm/Wであった。また、半減寿命は、2000時間であった。

【0062】

[実施例9]

次に、この発明の実施例9について説明する。実施例9の有機EL素子の構造は、実施例1の素子の構造と同様である。ただし、実施例9においては、無機非縮退半導体層として、In-Zn-Al-O-Nからなる酸化物の層をスパッタリングにより形成した。なお、この酸化物は、正孔伝導性を有し、透明である。

【0063】

実施例9における無機非縮退半導体層のバンドギャップエネルギーは、下記の表1に示すように、3.1eVであった。また、比抵抗は、 $8 \times 10^2 \cdot \text{cm}$ であった。また、無機非縮退半導体層の状態は、非晶質であった。

そして、7.5Vの電圧を印加して定電圧駆動したときの発光効率は1.6lm/Wであった。また、半減寿命は、1500時間であった。

【0064】

[実施例10]

次に、この発明の実施例10について説明する。実施例10の有機EL素子の構造は、実施例1の素子の構造と同様である。ただし、実施例10においては、対向電極を、Al:Liの代わりに、Alで形成した。Alは、仕事関数が4.0eV以上あるので、耐久性が高い。

【0065】

また、実施例10においては、無機非縮退半導体層として、In-Zn-Ba-Oからなる酸化物の層をスパッタリングにより形成した。なお、この酸化物は、正孔伝導性を有し、透明である。

スパッタリングにあたっては、In、ZnおよびBaに対するInの原子数比を0.57~0.6の範囲内の値とした。また、In、ZnおよびBaに対するBaの原子数比を0.1~0.23の範囲内の値とした。また、スパッタリングの出力を20Wとした。その他のスパッタリングの条件は、実施例1と同一条件とした。

【0066】

実施例10における無機非縮退半導体層のバンドギャップエネルギーは、下記の表1に示すように、3.0eVであった。また、比抵抗は、 $4 \times 10^{-2} \cdot \text{cm}$ であった。また、無機非縮退半導体層の状態は、非晶質であった。

そして、7.5Vの電圧を印加して定電圧駆動したときの発光効率は2.1lm/Wであった。また、半減寿命は、3200時間であった。

【0067】

[実施例11]

次に、この発明の実施例11について説明する。実施例11の有機EL素子の構造は、実施例10の素子の構造と同様である。ただし、実施例11においては、無機非縮退半導体層として、In-Zn-Sr-Oからなる酸化物の層をスパッタリングにより形成した。なお、この酸化物は、正孔伝導性を有し、透明である。

【0068】

スパッタリングにあたっては、In、ZnおよびSrに対するInの原子数比を0.57~0.6の範囲内の値とした。また、In、ZnおよびSrに対するSrの原子数比を0.1~0.23の範囲内の値とした。その他のスパッタリングの条件は、実施例1と同一条件とした。

【0069】

実施例11における無機非縮退半導体層のバンドギャップエネルギーは、下記の表1に示すように、2.8eVであった。また、比抵抗は、 $3 \times 10^{-2} \cdot \text{cm}$ であった。また、無機非縮退半導体層の状態は、非晶質であった。

10

20

30

40

50

そして、7.5Vの電圧を印加して定電圧駆動したときの発光効率は2.4lm/Wであった。また、半減寿命は、4000時間であった。

【0070】

【表1】

実施例	酸化物	比抵抗 (Ω・cm)	エネルギーギャップ (eV)	状態	効率 (lm/vv)	半減寿命 (時間)
1	In-Zn-Al-O	1×10	2.9	非晶質	1.2	750
2	In-Zn-Si-O	1×10 ²	2.9	非晶質	1.2	800
3	In-Zn-Mg-O	2×10	3.0	微結晶	1.5	1200
4	In-Zn-Yb-O	3×10 ⁻¹	3.1	非晶質	1.0	650
5	In-Ga-Si-O	3×10 ⁻²	3.0	微結晶	0.9	700
6	In-Ga-Al-O	1×10	2.9	微結晶	1.3	720
7	In-Zn-Ta-O	7×10	2.8	非晶質	1.2	450
8	In-Zn-Si-O-N	7×10 ³	3.1	非晶質	1.4	2000
9	In-Zn-Al-O-N	8×10 ²	3.1	非晶質	1.6	1500
10	In-Zn-Ba-O	4×10 ⁻²	3.0	非晶質	2.1	3200
11	In-Zn-Sr-O	3×10 ⁻²	2.8	非晶質	2.4	4000

10

20

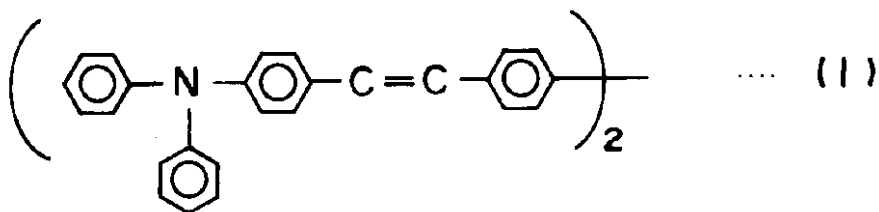
【0071】

[実施例12]

次に、この発明の実施例12について説明する。実施例12の有機EL素子の構造は、実施例1の素子の構造と同様である。ただし、実施例12においては、有機発光層として、下記の(1)式に示すPAVBiを用いた。このPAVBiは、正孔伝導性を有する。

【0072】

【化1】



40

【0073】

そして、印加電圧5Vで定電圧駆動したときの初期輝度は210cd/m²であり、発光効率は2.3lm/Wであった。また、半減寿命は、1300時間であった。また、発光光の色は、青緑色であった。

【0074】

なお、従来は、PAVBiの有機発光層と、オキサジアゾール誘導体の電子注入層とを組み合わせて用いた例が知られている。この組み合わせでは、発光効率は高くなるが、寿命

50

が50時間と極めて短い。

【0075】

(参考例)

次に、この発明の参考例について説明する。参考例の有機EL素子の構造は、実施例12の素子の構造と同様である。ただし、参考例においては、無機非縮退半導体層としてのIn-Zn-Si-Oを除去している。

【0076】

そして、5Vの電圧を印加して定電圧駆動したときの初期輝度は180cd/m²であり、発光効率は2.0lm/Wであった。また、半減寿命は、800時間であった。

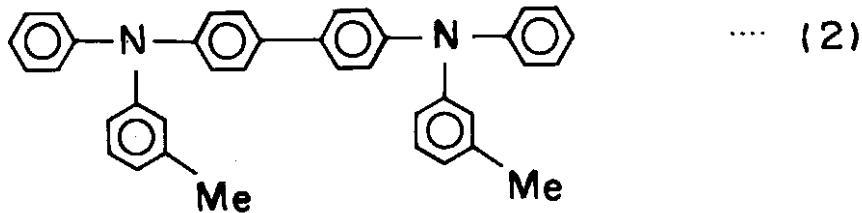
【0077】

(比較例1)

次に、比較例1について説明する。比較例1の有機EL素子の構造は、実施例1の構造と同様である。ただし、比較例1では、無機非縮退半導体層の代わりに、有機正孔注入材である下記の(2)式に示すTPDを用いた。

【0078】

【化2】



【0079】

そして、6.5Vの電圧を印加して定電圧駆動したときの初期輝度は130cd/m²であったが、半減寿命はわずか120時間であった。

【0080】

(比較例2)

次に、比較例2について説明する。比較例2の有機EL素子の構造は、実施例1の構造と同様である。ただし、比較例2では、無機非縮退半導体層として、正孔伝導性のマイクロクリスタルSi(P-μC-Si)層を、プラズマCVD法により、厚さ30nmで製膜した。

【0081】

製膜にあたっては、プラズマCVD装置を用いて、RF出力を800W、基板温度を300、圧力を20mTorrとし、導入ガスとしてSiH₄/H₂/B₂H₆(6000ppm)を導入した。

【0082】

比較例2における無機非縮退半導体層のバンドギャップエネルギーは、2.3eVであった。また、比抵抗は、1×10⁵・cmであった。

そして、6Vの電圧を印加して定電圧駆動したときの初期輝度は120cd/m²であり、輝度は10cd/m²であり、発光効率はわずか0.2lm/Wであった。また、半減寿命はわずか10時間であった。

【0083】

比較例1および比較例2と、実施例1とを比較すると、無機半導体は、正孔伝導に対する安定性が、有機化合物に比べてはるかに高いことが分かる。さらに、バンドギャップエネルギーの大きな無機非縮退半導体層は、電子障壁性を有し、かつ、正孔伝導に対する安定性が高いことが分かる。

【0084】

(比較例3)

次に、比較例3について説明する。比較例3の有機EL素子の構造は、実施例1の構造と

10

20

30

40

50

同様である。ただし、比較例 3 では、無機非縮退半導体層として、 InZnO を用いている。 InZnO のキャリア濃度は、 10^{20} cm^{-3} である。また、比抵抗は、 $5 \times 10^{-4} \cdot \text{cm}$ と小さい。

【0085】

そして、6 V の電圧を印加して定電圧駆動したときの発光効率は、わずか 0.25 lm/W であった。発光効率が低い理由は、無機非縮退半導体層のキャリア濃度が高いためであると考えられる。

【0086】

【発明の効果】

以上、詳細に説明した様に、この発明によれば、無機非縮退半導体層を非晶質材料または微結晶材料でもって形成したので、表面の凹凸に起因するリーク電流の発生の防止を図ることができる。このため、発光効率の向上を図ることができる。

10

【0087】

また、この発明によれば、無機非縮退半導体層のバンドギャップエネルギーを、有機発光層のバンドギャップエネルギーよりも大きくした。その結果、有機発光層で生成された励起状態が、無機非縮退半導体層へエネルギー移動して失活することの低減を図ることができる。このため、発光効率の向上を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

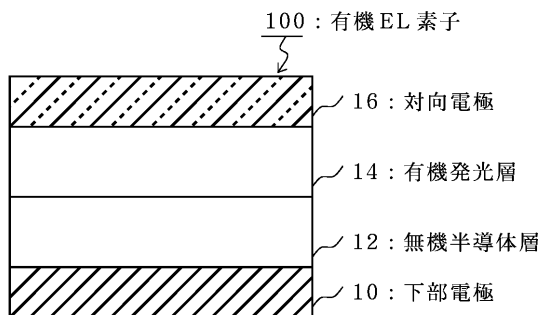
【図 1】本発明の有機 EL 素子の第 1 の実施の形態の説明に供する断面図である。

【符号の説明】

20

- 10 第 1 電極層、下部電極
- 12 無機非縮退半導体層
- 14 有機発光層
- 16 第 2 電極層、対向電極
- 100 有機 EL 素子

【図 1】



フロントページの続き

- (56)参考文献 国際公開第97/047050(WO, A1)
特開平05-003080(JP, A)
特開平09-260062(JP, A)
特開平09-129376(JP, A)
特開平04-175394(JP, A)
国際公開第97/046054(WO, A1)
特表平11-511895(JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

- H01L 51/50-51/56
H01L 27/32
H05B 33/00-33/28